## Работа 4.4. Усилители мощности

Усилители мощности используют в выходных каскадах усилителей. Их заданной основное назначение \_ передача мощности нагрузку. Коэффициент усиления напряжения является для усилителей мощности второстепенным параметром. Наиболее важными являются коэффициент усиления мощности, КПД, степень нелинейных искажений выходного сигнала. Как правило, коэффициент усиления напряжения выходных каскадов близок к единице. Усиление мощности достигается за счет усиления тока. Необходимость увеличения КПД обусловлена тем, что большая часть мощности источника питания потребляется выходными каскадами усилителя. Поэтому слишком большая мощность, рассеиваемая усилителем, может привести к перегреву транзисторов.

Существует несколько режимов работы усилителей, отличающихся положением рабочей точки на передаточной характеристике и обеспечивающих различные значения КПД. Различают три основных режима усилительных каскадов или классов усиления: A, B и C. Они отличаются коэффициентом полезного действия и уровнем нелинейных искажений.

Рассмотрим основные режимы работы усилителей на примере эмиттерного повторителя (рис. 4.4.1), который часто используют в качестве усилителя мощности. Во всех рассматриваемых случаях коллекторный переход смещен в обратном направлении. Режим усилителя зависит от того, как смещен эмиттерный переход в отсутствии входного сигнала.

**Режим А**. В этом режиме эмиттерный переход смещен так, что схема всегда функционирует на линейном участке передаточной характеристики, а транзистор никогда не переходит в режим насыщения. В схеме на рис. 4.4.1 напряжения  $E_{\rm K}$  и  $E_{\rm 9}$  равны, и рабочая точка находится на линейном участке передаточной характеристики (рис. 4.4.2).

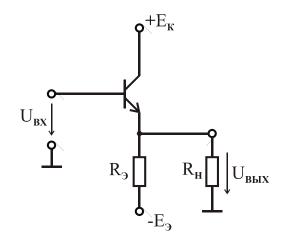


Рис. 4.4.1

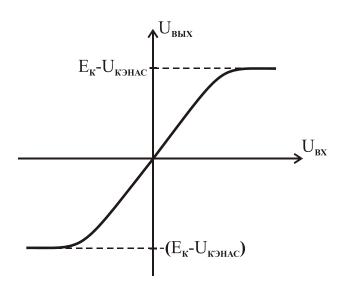


Рис. 4.4.2

Полный размах напряжения выходного сигнала не превышает напряжения питания  $E_{\kappa}$ . Например, если  $E_{\kappa}=10~\mathrm{B}$ , то и амплитуда выходного напряжения не может превышать  $10~\mathrm{B}$ . Если к тому же необходимо обеспечить минимальные искажения выходного сигнала, его размах ограничивают значениями, меньшими  $E_{\kappa}$ .

Мощность, отдаваемая в нагрузку усилителем, работающим в режиме А

$$P_{_{
m H}} = \frac{\left(U_{_{
m BЫX}}/\sqrt{2}\right)^2}{R_{_{
m H}}} = \frac{1}{2} \frac{U_{_{
m BЫX}}^2}{R_{_{
m H}}} \, .$$

Здесь  $U_{\text{вых}}$  – амплитуда выходного напряжения. Мощность, отдаваемая источником питания,

$$P_{\text{\tiny MCT}} = 2E_{\text{\tiny K}}I$$
.

В последнем выражении учтено, что в схеме на рис. 4.4.1 используется расщепленный источник и  $E_{\kappa}=E_{2}$ .

Коэффициент полезного действия равен отношению мощности, выделяемой в нагрузке, к мощности, отдаваемой источником питания:

$$\eta = \frac{P_{\rm H}}{P_{\rm HCT}} = \frac{1}{4} \frac{U_{\rm BbIX}^2}{R_{\rm H} E_{\rm K} I}.$$

Коэффициент полезного действия достигнет наибольшего значения, равного 25 %, когда амплитуда выходного напряжения максимальна, т. е.  $U_{\rm вых} = E_{\rm k} = R_{\rm H} I$ . Поскольку для уменьшения нелинейных искажений амплитуду выходных напряжений ограничивают значениями, меньшими  $E_{\rm k}$ , КПД усилителей, работающих в режиме A, оказывается еще меньше. Если в

нагрузке выделяется максимальная мощность (при равенстве выходного сопротивления повторителя и сопротивления нагрузки), а размах выходного напряжения равен  $E_{\kappa}/2$ , то КПД равен всего лишь 6.25 %.

Низкий КПД в режиме А определяется тем, что постоянная составляющая тока через транзистор не зависит от входного сигнала. Поэтому мощность, потребляемая от источника в этом режиме, постоянна. Более того, мощность, рассеиваемая транзистором, максимальна при отсутствии входного сигнала.

Поскольку коэффициент полезного действия усилителей, работающих в режиме A, невелик, в качестве усилителей мощности их не используют. Главное достоинство режима A состоит в малой величине искажений усиливаемого сигнала.

**Режим В.** В этом режиме эмиттерный переход смещен так, что рабочая точка находится на границе области отсечки. Обратимся еще раз к схеме эмиттерного повторителя на рис. 4.4.1. Примем, что напряжение  $E_{_{9}}=0$ . Передаточная характеристика, соответствующая этому случаю, показана на рис. 4.4.3.

Если входной сигнал отсутствует, эмиттерный переход смещен в обратном направлении и транзистор находится в состоянии отсечки. За счет этого снижается мощность, потребляемая от источника питания.

входное напряжение положительно, эмиттерный переход отпирается транзистор переходит В активный режим. Выходное положительной полуволны повторяет форму выходного напряжение напряжения. Во время отрицательной полуволны входного напряжения эмиттерный переход смещен в обратном направлении, транзистор находится в состоянии отсечки и выходное напряжение равно нулю. Графики напряжений на входе и выходе повторителя, работающего в режиме В, показаны на рис. 4.4.4.

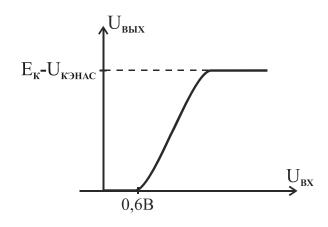


Рис. 4.4.3

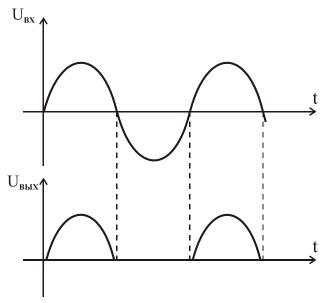


Рис. 4.4.4

Режим В позволяет значительно увеличить КПД усилителя, поскольку при отсутствии входного сигнала ток транзистора равен нулю. Следовательно, равна нулю и мощность, потребляемая от источника. Однако форма выходного сигнала при этом сильно искажена.

**Двухтактный эмиттерный повторитель**. Для того чтобы получить на выходе сигнал обеих полярностей, используют комплементарную схему, содержащую транзисторы n-p-n и p-n-p-типов (рис. 4.4.5). Она состоит по существу из двух эмиттерных повторителей, один из которых усиливает положительную, а другой — отрицательную полуволну входного сигнала. Эту схему часто называют *двухтактным эмиттерным повторителем*.

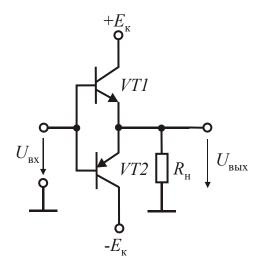


Рис. 4.4.5

При отсутствии входного сигнала оба транзистора находятся в состоянии отсечки, поскольку напряжения на эмиттерных переходах равны нулю. Во время положительной полуволны входного напряжения

открывается n-p-n-транзистор VT1, а во время отрицательной – p-n-p-транзистор VT2.

Коэффициент полезного действия двухтактного эмиттерного повторителя

$$\eta = \left(\frac{1}{2} \frac{U_{\text{вых}}^2}{R_{\text{H}}}\right) / \left(\frac{2}{\pi} \frac{U_{\text{вых}}}{R_{\text{H}}} E_{\text{K}}\right) = \frac{\pi}{4} \frac{U_{\text{вых}}}{E_{\text{K}}}.$$
 (4.4.1)

Здесь  $U_{\scriptscriptstyle \mathrm{BMX}}$  — амплитуда выходного напряжения.

Из (4.4.1) следует, что КПД схемы возрастает с увеличением амплитуды выходного напряжения и достигает своего максимального значения при  $U_{\scriptscriptstyle \mathrm{BMX}} = E_{\scriptscriptstyle \mathrm{K}}$  :

$$\eta = \frac{\pi}{4} = 0.785$$
.

Таким образом, двухтактная схема обладает значительно большим КПД, чем обычный эмиттерный повторитель.

Напряжение на выходе двухтактной схемы отличается от выходного на величину падения напряжения на эмиттерном переходе. Следовательно,  $U_{\text{вых}} \approx U_{\text{вх}}$ , т. е. схема является повторителем напряжения. Коэффициент усиления тока  $K_I \approx \beta$ . Усиление мощности происходит за счет усиления тока.

Пример 4..4.1. Рассчитать двухтактный усилитель мощности, если мощность нагрузки  $P_{\rm H}=20~{\rm BT}$ , а сопротивление нагрузки  $R_{\rm H}=8~{\rm OM}$ . Для уменьшения нелинейных искажений напряжение источника питания должно превышать амплитуду выходного напряжения на 5 В.

Решение. Поскольку мощность, выделяемая в нагрузке:

$$P_{\rm H} = \frac{\left(U_{\rm BMX} / \sqrt{2}\right)^2}{R_{\rm H}},$$

амплитуда выходного напряжения

$$U_{_{
m BMX}} = \sqrt{2P_{_{
m H}}R_{_{
m H}}} = \sqrt{2\cdot20\cdot8} = 17.9~{
m B}\,.$$

Напряжение питания  $E_{\mbox{\tiny K}} = U_{\mbox{\tiny Bых}} + 5 = 17,9 + 5 \approx 23 \ \mbox{B} \, .$  Амплитуда выходного тока

$$I_{\text{вых}} = \frac{U_{\text{вых}}}{R_{\text{H}}} = \frac{17.9}{8} = 2.24 \text{ A}.$$

Мощность, потребляемая транзисторами от источников питания:

$$P_{+} + P_{-} = \frac{2}{\pi} \frac{U_{\text{вых}}}{R_{\text{H}}} E_{\text{K}} = \frac{2}{\pi} \frac{17.9}{8} 23 = 32.8 \text{ Bt}.$$

Максимальная мощность, рассеиваемая каждым транзистором:

$$P_{VT1} = P_{VT1} = \frac{E_{\kappa}^2}{\pi^2 R_{H}} = \frac{529}{\pi^2 \cdot 8} = 6.7 \text{ Bt}.$$

4.4.5 свойственны Двухтактной рис. схеме на значительные нелинейные искажения, называемые переходными. Они обусловлены нелинейностью начального участка передаточной характеристики эмиттерного повторителя (рис. 4.4.6). В диапазоне изменения входного напряжения  $-0.6 < u_{\text{вх}} < 0.6 \text{ B}$  оба транзистора находятся в режиме отсечки и передаточная характеристика имеет горизонтальный излом. Переходные искажения проявляются тем сильнее, чем меньше размах входного напряжения.

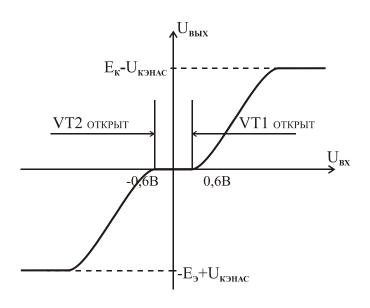


Рис. 4.4.6

Для уменьшения переходных искажений используют промежуточный режим AB. В этом режиме на базы транзисторов подаются небольшие напряжения смещения. Это позволяет устранить излом начального участка передаточной характеристики и уменьшить переходные искажения.

Обычно источником смещения служат диоды, стабилитроны или транзисторы в диодном включении. Один из вариантов схемы, работающей в режиме AB, показан на рис. 4.4.7.

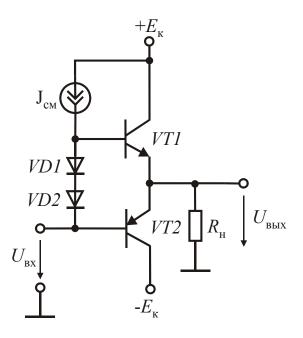


Рис. 4.4.7

Диоды, включенные между базами транзисторов, создают на эмиттерных переходах транзисторов дополнительное смещение. За счет этого при  $u_{\rm вx}=0$  транзисторы работают в активном режиме. Как только входное напряжение становится положительным, транзистор VT2 переходит в режим отсечки. При отрицательном входном напряжении в отсечке находится VT1. При  $u_{\rm вx}=0$  по крайней мере один из транзисторов находится в активном режиме. Таким образом, диоды существенно уменьшают переходные искажения и позволяют получить передаточную характеристику, близкую к линейной. Часто в качестве диодов используют транзисторы с зашунтированными коллекторными переходами.

Другая схема усилителя мощности, имеющего малые переходные искажения, показана на рис. 4.4.8. На входе включены эмиттерные повторители на транзисторах VT1 и VT2. Они создают необходимое напряжение смещения на эмиттерных переходах транзисторов VT3 и VT4. Кроме того, эмиттерные повторители обеспечивают высокое входное сопротивление схемы.

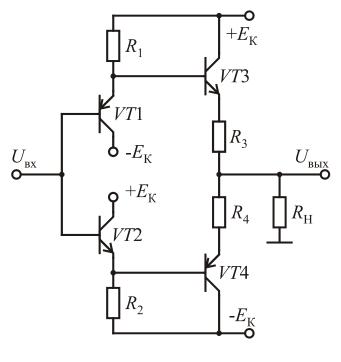


Рис. 4.4.8

Таким образом, цепь на рис. 4.4.8 является буферным усилителем, работающим в режиме AB, и имеющим коэффициент усиления напряжения, равный единице.

## Рекомендации по сборке схем

## Рекомендуемая литература

- 1. Гусев, В. Г. Электроника и микропроцессорная техника: учеб. для вузов / В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев. 3-е изд. перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2004. 790 с.
- 2. Быстров, Ю. А. Электронные цепи и микросхемотехника: учеб. / Ю. А. Быстров, И. Г. Мироненко. М.: Высш. шк., 2002. 384 с.: ил.
- 3. Степаненко, И. П. Основы микроэлектроники: учеб. пособие для вузов / И.П. Степаненко. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2003. 488 с.: ил.
- 4. Хоровиц, П. Искусство схемотехники / П. Хоровиц, У. Хилл: пер. с англ. 6-е изд. М.: Мир, 2003. 704 с., ил.
- 5. Довгун, В. П. Электротехника и электроника: учеб. пособие: в 2-х ч. Ч. 2 / В. П. Довгун. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2006. 252 с.